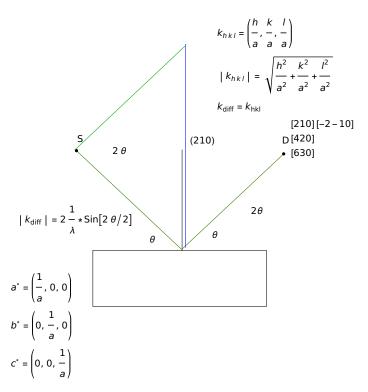
Домашняя контрольная работа

Александр Нехаев

Задача 1

У вас тяжелый день - вместо монокристальных подложек Si (510) Вам привезли подложки Si (210). Руководитель требует от Вас оценки возможности использования этих подложек в Ваших экспериментах. Обычно Вы проводите съемку на $CrK\alpha_1$, λ =2.2897 Å, геометрия "на отражение" в режиме симметричного сканирования. На каком углу Вы увидите первый рефлекс? Кремний Si - кубический кристалл, Fd-3m, a = 5.4309 Å.

Решение



Условие наблюдения дифракционного максимума: $\vec{k'} - \vec{k} = \vec{q_{\rm hkl}}$. В свою очередь:

$$\left| \vec{k'} - \vec{k} \right| = 2 \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot \sin \left(\frac{2\theta}{2} \right)$$

$$\left| \overrightarrow{q_{\text{hkl}}} \right| = \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}{a}$$

тогда

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \lambda}{2 a}$$

Рассматриваем подложку (510). Величина угла для нее:

In[1]:=
$$n = 1$$
;
 $\lambda = 2.29 \text{ Å}$;
 $a = 5.4309 \text{ Å}$;
 $h = 5$;
 $k = 1$;
 $l = 0$; $\frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \lambda}{2 a}$
Out[6]= 1.07503

Видим, что условие дифракции не выполняется, поскольку синус угла больше 1.

Рассматриваем подолжку (210). Угол будет:

$$\begin{array}{ll} & \text{In[7]:=} & h = 2; \\ & k = 1; \\ & l = 0; \\ & & \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \lambda}{2 a} \\ & & \text{Out[10]=} & 0.471432 \end{array}$$

Синус угла меньше 1, однако не выполнено условие отражения для пространственной группы Fd-3m:

$$\label{eq:local_local_local_local} $$ \ln[11]:= $$ $ \{ HoldForm [h+k], EvenQ[h+k] \} $$ /. False $\to "Het" // Dataset $$ $$ Out[11]:= $$ $$ $$ h+k $$ $$ Het $$$$

Следующий вектор (420). Сразу проверяем условия отражения:

$$\label{eq:heating_loss} $h=4$; $$$ k=2$; $$$$ l=0$; $$$ {{HoldForm\,[h+k], \, HoldForm\,[h+l], \, HoldForm\,[k+l]}, $$$$ EvenQ /@ {h+k, h+l, k+l}}^\intercal /. True \to "Да" // Dataset$$

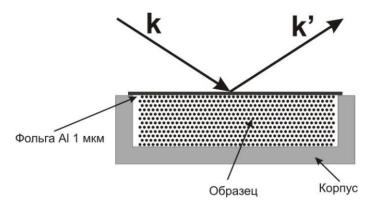
	h+k	Да
Out[15]=	h+l	Да
	k+l	Да

Теперь находим угол 2θ (в градусах):

$$\ln[16] := \frac{2}{\circ} \operatorname{ArcSin} @ \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}{2 a} \lambda$$
Out[16] = 141.076

Задача 2

Все события в один день! После подложек Вам привезли специальную ячейку для исследования в режиме in situ. Ее конструкция проста (k, k' - волновые вектора первичного и вторичного пучков):



Вы работаете в режиме симметричного сканирования на Сг Ка 1, λ = 2.2897 Å, геометрия "на отражение". Определите угловую зависимость ослабления интенсивности рефлексов фольгой. Насколько сильно уменьшится интенсивность рефлекса на 10° 20? На 50° 2θ ? Массовый коэффициент поглощения Сг К α_1 для алюминия 157.5 см 2 / г, плотность алюминия 2.7 г / см 3 .

Решение

$$ln[17]:=$$
 $\lambda = 2.29 \text{ Å}$;
 $\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$;
 $\mu = 157.5 \text{ cm}^2/\text{g}$;
 $z = 1 \mu\text{m}$;

Закон Бугера-Ламберта-Бэра:

$$I_x = I_0 e^{-\mu x}$$

Закон Мозли:

$$x = \frac{2 \rho z}{\sin(\theta)}$$

Коэффициент 2 отражает, что луч проходит фольгу 2 раза.

Итоговая формула для отношения будет иметь вид:

$$\frac{I_{x}(2 \theta)}{I_{0}} = e^{-\mu \frac{2 \rho z}{\sin(\theta)}}$$

Находим искомые отношения $\left(\frac{I(10\,^\circ)}{I_0}$ и $\frac{I(50\,^\circ)}{I_0}\right)$:

In[21]:= iRelation [θ_] := Exp[-
$$\mu * \rho * \frac{2 z}{Sin[\theta]}$$
];

res = iRelation /@ ({10 °, 50 °} / 2);

⟨|"10°" → res[1], "50°" → res[2]|> // Dataset

10° 0.376876

50° 0.817712

Задача 3

Рассчтайте интенсивность рефлексов (100) и (111) на дифрактограмме поликристаллического образца CuAu $_3$ ($\alpha=3.965$ Å, S.G. Pm-3m, координаты атомов Cu(0,0,0) и Au(0.5,0.5,0.0), тепловыми колебаниями пренебрегайте, заселенности позиций единичные). Для упрощения расчетов считайте, что рассеивающий фактор атома $F=Ze^{\frac{\sin \theta}{\lambda}}$ ($\lambda=[\hbar]$ - показатель экспоненты в \hbar^{-1} , Z - атомный номер), аномальным рассеянием можно пренебречь. Съемка проводится на излучении CuK α_1 , $\lambda=1.5406$ Å, геометрия "на отражение", монохроматор отсутствует. Считайте единичными интенсивность первичного пучка, абсорбционный фактор, текстурный фактор и фактор экстинкции.

Решение

План действий:

1. Углы дифракционные
$$\left(d_{\mathrm{hkl}} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}\right) \rightarrow 2 \ d_{\mathrm{hkl}} = \mathrm{Sin}[q_{\mathrm{hkl}}] = \lambda \rightarrow 2 \ \theta$$

- **2.** p(100) = 6, p(111) = 8
- **3.** LPG= 2θ
- **4.** F_{Cu} , $F_{\text{Au}} < -2 \theta$
- **5.** $(100) = F_{\text{Cu}} + F_{\text{Au}} F_{\text{Au}} F_{\text{Au}} = F_{\text{Cu}}(2 \theta) F_{\text{Au}}(2 \theta)$
- **6.** LPG $(2 \theta) * p (100) * | F_{100}|^2$

Решение

Начнем с уравнения интенсивности рефлекса на дифрактограмме. В полной форме оно имеет вид:

$$I_{\text{hkl}} = p_{\text{hkl}} \cdot A \cdot \text{LPG} \cdot T(h \ k \ l) \cdot E_{\text{hkl}} \cdot |F_{\text{hkl}}|^2$$

Однако по условию:

$$A = 1$$
, $T(hkl) = 1$, $E_{hkl} = 1$

поэтому:

$$I_{hkl} = p_{hkl} \cdot LPG \cdot |F_{hkl}|^2$$
.

Теперь будем выражать переменные, входящие в полученное уравнение по порядку.

1. $p_{\rm hkl}$ - фактор повторяемости для рефлексов 100 и 111 соотвественно:

$$ln[24]:= p = {6, 8};$$

2. Теперь рассматриваем LPG- фактор. Для его нахождения нам нужны значения углов 2 θ . Для этого сначала находим межплоскостные расстояния $d_{\rm hkl}$ по формуле (1).

$$d_{\rm hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{1}$$

$$\begin{array}{ll} & \text{In[25]:=} & \text{a = 3.965 Å ;} \\ & \lambda = \text{ 1.541 Å ;} \\ & \text{reflects = \{\{1,\,0,\,0\},\,\{1,\,1,\,1\}\};} \\ & d_{\text{hkl}} = \frac{\text{a}}{\sqrt{\text{Total}\left[\sharp^2\right]}} \;\&\,\text{/@ reflects ;} \end{array}$$

Association [{HoldForm $[d_{hkl}] \rightarrow \#}] \&@$

$$\left(\text{Rule}[\#[1], \#[2]] \& /@ \left(\left\{ \left(\# \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right] [1] \& /@ \text{ (reflects)}, d_{hkl} \right\}^{\intercal} \right) \text{// Association} \right) \text{//}$$

Dataset

3.965 Å d_{hkl} 100 2.28919 Å 111

Out[29]=

Затем используя закон Брэгга (2) находим значения углов 2 θ .

$$2 d_{hkl} \sin(\theta) = \lambda n$$

$$\sin(\theta) = \frac{\lambda n}{2 d_{hkl}}$$
(2)

$$n[30]:=$$
 $n = 1;$

$$Os = ArcSin \left[\frac{n \lambda}{2 \# \& /@ d_{hkl}} \right];$$

2 Θs/°;

Association $[\{"\theta^{\circ}" \rightarrow \#\}] \&@$

$$\left(\text{Rule} [\#[1], \#[2]] \& /@ \left(\left\{ \left(\# . \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right| [1] \& /@ \text{ (reflects), 2 Os /°} \right\}^\intercal \right) \text{// Association } \right) \text{// Dataset}$$

Out[33]=

θ°	100	22.4106
	111	39.3375

Для пространственной группы Pm - 3 m отсутствуют условия погасания и первые пики рассматриваемых рефлексов будут наблюдаться на полученных углах.

LPG - фактор находится по формуле:

$$LPG[\theta] = \frac{1 + \cos(2\theta)^2}{\sin(\theta)^2 \cos(\theta)}$$

Находим соотвествующие значения из полученных углов:

$$ln[34]:= LPG[O_] := \frac{1 + Cos[2 O]^2}{Sin[O]^2 Cos[O]};$$

LPG /@ 0s;

Association [{"LPG" $\rightarrow \#$ }] &@

$$\left(\text{Rule}[\#[1], \#[2]] \& /@ \left(\left\{ \left(\# . \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \| 1 \| \& /@ \text{ (reflects), LPG } /@ \Theta s \right\}^\intercal \right) \text{ // Association } \right) \text{ // Association } \text{ // Associ$$

Dataset

Out[36]=

LPG	100	50.0683
	111	14.9815

3. Теперь ищем структурную амплитуда. Её формула имеет вид:

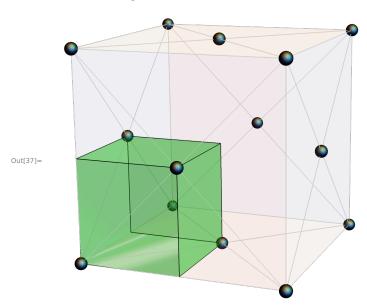
$$F_{\rm hkl} = \sum_{j} g_j \ t_j(q_{\rm hkl}) \ e^{2\pi i (h \, x_j + k \, y_j + l \, z_j)} \cdot F_j^{\rm atom}(q_{\rm hkl})$$

По условию мы пренебрегаем тепловыми колебаниями, откуда $t_j(q_{hkl}) = 1$, заселенности позиций g_j так же единичные.

Суммируем по атомам в элементарной ячейке - по одному Си и по 3м Аи. Формула принимает вид:

$$F_{\text{hkl}} = \sum_{j} e^{2\pi i (h x_j + k y_j + l z_j)} \cdot Z \cdot e^{-\frac{\sin(\theta)}{\lambda}}$$

С учетом структуры решетки, определяем координаты атомов в элементарной ячейке (выделена зеленым для наглядности).



Получаем, что для Cu кординаты (0,0,0), а для атомов Au: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

In[38]:=

Наконец структурные амплитуды для 100 и 111 соотвественно (Z_{Cu} = 29, Z_{Au} = 79):

4. В итоге интенсивности:

In[45]:= Ihkl = (p * LPG[0s] * Abs[F]²);
Association [{"I"
$$\rightarrow$$
 #}] &@
$$\left(\text{Rule}[\#[1], \#[2]] \& /@ \left(\left\{ \left(\# . \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right\| 1 \right] \& /@ (\text{reflects}), \text{ ScientificForm } /@ \text{ Ihkl} \right\}^{\intercal} \right) / \text{Association} \right) / / \text{ Dataset}$$
Out[46]=
$$\left(7.51025 \times 10^{5} \right) e^{-2.52207 \times 10^{-1} / \mathring{A}}$$

$$\left(8.48026 \times 10^{6} \right) e^{-4.36835 \times 10^{-1} / \mathring{A}}$$

На рентгенограмме ромбического соединения GdFeO 3 имеются следующие линии: 3.870 Å (110), 2.806 Å (020) и 2.725 Å (112). Определите параметры элементарной ячейки. Определите число формульных единиц на ячейкуZ, если $\rho_{\text{пикн.}} = 7.510 \text{ г/см}^3$ $(M_{\rm Gd} = 157.25 \; ; M_{\rm Fe} = 58.85 \; ; M_O = 16.00 \,).$

Решение

Задача 4

Вектор обратной решетки для ромбического соединения:

$$\frac{1}{d_{\text{hkl}}} = \sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}$$

Записываем систему уравнений в матричном виде исходя из рефлексов:

$$\begin{pmatrix} h_1^2 & k_1^2 & l_1^2 \\ h_2^2 & k_2^2 & l_2^2 \\ h_3^2 & k_3^2 & l_3^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{-2} \\ b^{-2} \\ c^{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{110}^{-2} \\ d_{020}^{-2} \\ d_{112}^{-2} \end{pmatrix}$$

Находим значения a, b, c соотвественно:

Зная значения а, b, c можем определить число формульных единиц в элементарной ячейке

$$z = \frac{\rho \cdot V \cdot N_a}{\sum_{i=1}^n M_i}$$

$$\begin{aligned} & \text{In}[48] := & \rho = 7.51 \text{ g/cm}^3 \text{ ;} \\ & \text{V} = (a * b * c)[1]; \\ & \text{M} = \text{Quantity [\sharp, "Grams"/"Moles"] \& $/@ ({157.25 , 58.85 , 16.00}) * {1, 1, 3}); \\ & z = \frac{\rho * \text{V} * 1 \text{ N}_A}{\Sigma_{i=1}^3 \text{ M[i]}} \end{aligned}$$

Задача 5

Рефлекс (311) нанопорошка γ – Al $_2$ O $_3$ (Пр. гр. Fd – 3 m, a = 7.9448 Å) по результатам профильного анализа хорошо аппроксимируется функцией Лоренца и имеет полуширину 0.3440°. Считая инструментальный вклад в полуширину линейно-аддитивным и равным 0.05°, рассчитайте эффективный размер ОКР. Съемка проводилась на излучении Си K α_1 .

Решение

Исходные данные:

Формула Шеррера:

$$r = \frac{\lambda K}{\beta \cos(\theta)}$$

Уравнение Брэгга

$$2 d_{hkl} \sin(\theta) = \lambda$$

Ищем d_{hkl} как $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$:

In[58]:=
$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Теперь ищем угол θ из уравнения Брэгга:

$$ln[59]:=$$
 $\theta = ArcSin @ \frac{\lambda}{2 d_{hkl}}$

Out[59]=
$$0.327474$$

Ищем интегральную ширину из полуширины с учетом инструментального вклада :

$$In[60]:=$$
 $\beta = \frac{\pi}{2}$ (FWHM - InstrumentalError)

Out[60]=
$$0.00806018$$

Наконец, находим эффективный размер (считаем K = 1):

$$ln[61]:= r = \frac{1 * \lambda}{\beta * Cos[\theta]}$$